

3DJ6 型硅 N 沟道耗尽型低频场效应晶体管										
	参 数 符 号	单 位	3DJ6					测试条件		
			D	E	F	G	H	符 号	单位	D~H
极 限 参 数	$P_{CM}$	m W	100					$T_{amb}$	℃	25
	$V_{(BR)G}$	V	$\geq 30$					$V_{DS}$	V	0
	$I_{SS}$							$I_G$	$\mu A$	-1
	$V_{(BR)D}$	V	$\geq 20$					$V_{GS}$	V	$V_{GS(off)} + (-1)$
主 要 技 术  限 参 数	$I_{DSS}$	m A	<0.35	0.3~3.5	1~3.5	3~6.5	6~10	$V_{DS}$	V	10
								$V_{GS}$	V	0
	$V_{GS( off )}$	V	$\leq 1-41$		$\leq 1-91$			$V_{DS}$	V	10
								$I_D$	$\mu A$	10
	$I_{GSS}$	n A	$\leq 100$					$V_{DS}$	V	0
								$V_{GS}$	V	-10
	$g_{fs}$	W S	$\geq 300$		$\geq 500$	$\geq 1000$	$\geq 1500$	$V_{DS}$	V	10
								$I_D$	mA	3
								f	KHz	1
	$C_{iss}$	P F	$\leq 4$					$V_{DS}$	V	10
								$I_D$	mA	3
	$C_{rss}$		$\leq 2$					f	KHz	1
	$F_n$	d B	$\leq 5$					$V_{DS}$	V	10
								$I_D$	mA	3
								f	KHz	1
								$R_g$	K Ω	1
$G_p$	d B	$\geq 10$					$V_{DS}$	V	10	
							f	KHz	30	
外形			<div><div><div>漏极</div><div>D</div><div>G</div><div>栅极</div><div>S</div><div>源极</div></div><div>N沟结构</div><div><div>D</div><div>S</div><div>G</div></div><div>A3-01B</div></div>							
备注			对应型号 GS1 型 D、E、F 档在 $V_{GS}=0$ 条件下测试							